

2SA935

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
中電力増幅 & スイッチング用/Medium Power Amp. & Switching
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor T-27-15

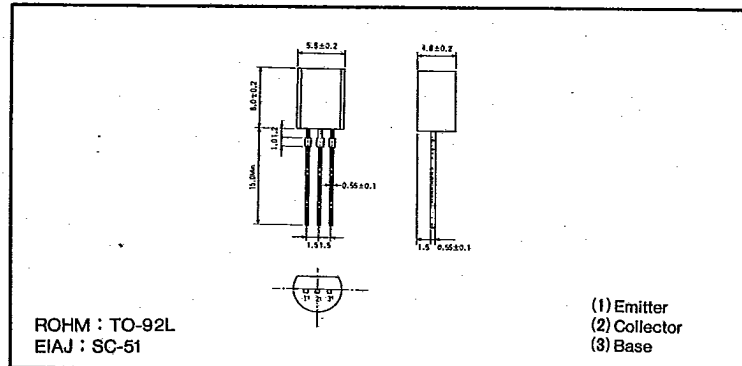
● 特長

- 1) 高耐圧である ($V_{CEO} = -80V$)。
- 2) 大電流である ($I_C \text{ Max} = -700mA$)。

● Features

- 1) High breakdown voltage
 $V_{CEO} = -80V$
- 2) Large current capacity
 $I_{C \text{ Max}} = -700mA$

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



トランジスタ
2SAタイプ

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-700	mA
コレクタ損失	P_C	750	mW
接合部温度	T_J	125	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	$^\circ C$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	-80	—	—	V	$I_C = -2mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-80	—	—	V	$I_C = -50 \mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-5	—	—	V	$I_E = -50 \mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{CB} = -50V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	-0.5	μA	$V_{EB} = -4V$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	$V_{CE} / I_C = -3V / -100mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	-0.2	-0.4	V	$I_C / I_B = -500mA / -50mA$
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f_T	—	100	—	MHz	$V_{CE} = -10V, I_E = 50mA$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	14	20	pF	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク	テーピング
		記号		T103
		基本発注単位 (個)	1 000	2 500
2SA935	PQR		◎	◎

ROHM

121

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

T-27-15

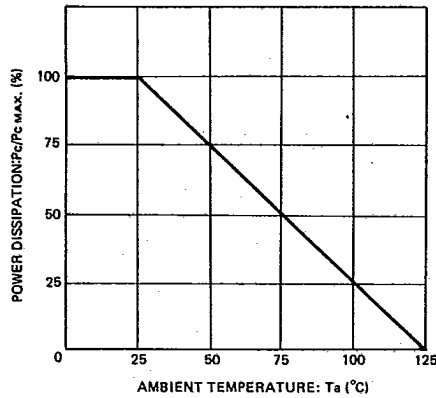


Fig.1 電力軽減曲線

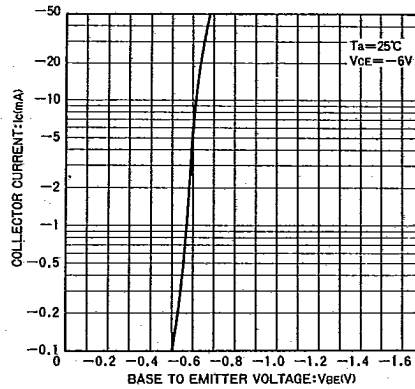


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

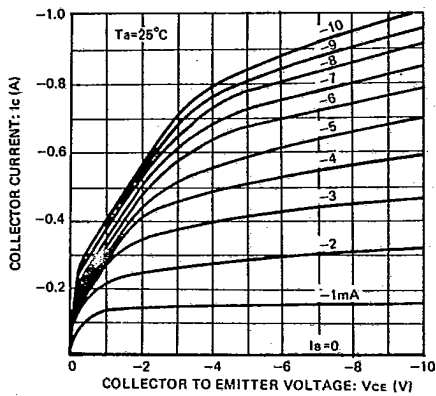


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

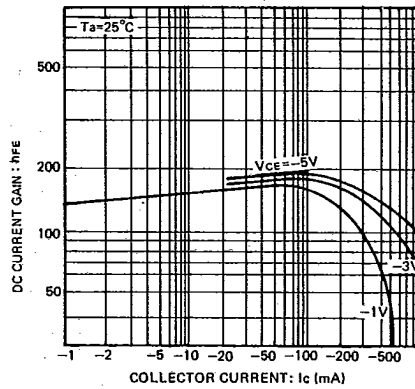


Fig.4 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

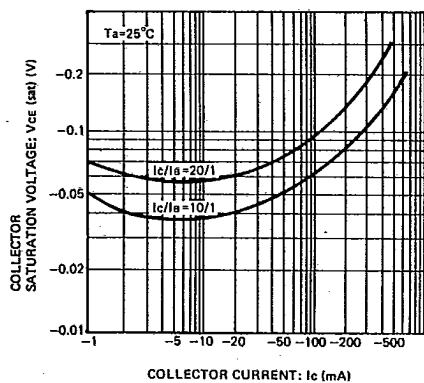


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧-コレクタ電流特性

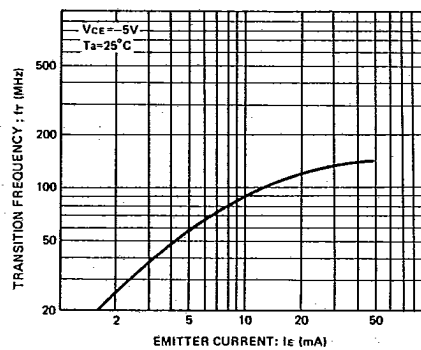


Fig.6 利得帯域幅積-エミッタ電流特性

T-27-15

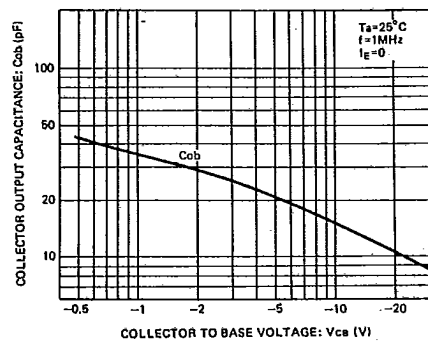


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

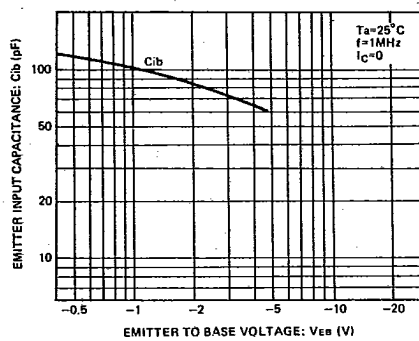


Fig.8 エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性

トランジスタ
2SAタイプ